



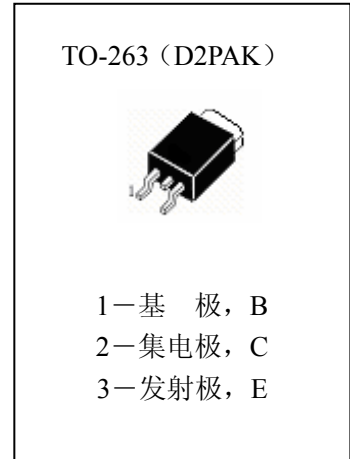
■ 主要用途

高压快速开关

■ 外形图及引脚排列

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150 $^\circ\text{C}$
T_j ——结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C ——集电极功率耗散($T_c=25^\circ\text{C}$)	80W
V_{CBO} ——集电极—基极电压	700V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	9V
I_C ——集电极电流(DC)	8A
I_C ——集电极电流(脉冲)	16A
I_B ——基极电流	4A



■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$BV_{CEO(sus)}$	集电极—发射极维持电压*	400			V	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益*	10		40		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{A}$
		5		30		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压*			1	V	$I_C=2\text{A}, I_B=0.4\text{A}$
				2	v	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}$
				3	V	$I_C=8\text{A}, I_B=2\text{A}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压*			1.2	V	$I_C=2\text{A}, I_B=0.4\text{A}$
				1.6	V	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		110		pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=0.1\text{MHz}$
f_T	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.5\text{A}$
t_{on}	导通时间			1.6	μs	} $V_{CC}=125\text{V}, I_C=5\text{A},$ $I_{B1}=-I_{B2}=1\text{A}$
t_s	载流子贮存时间			3	μs	
t_f	下降时间			0.7	μs	

分档: H1 (10--16) H2 (14--21) H3 (19--26) H4 (24--31) H5 (29--40)



■ 特性曲线

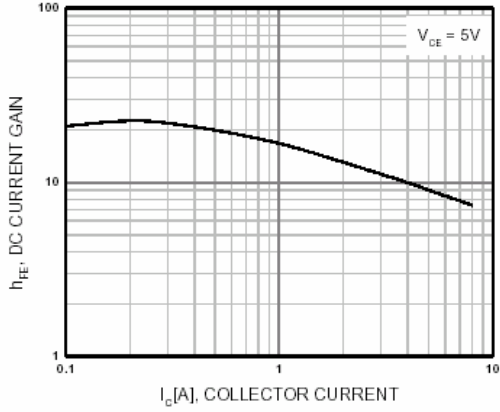


Figure 1. DC current Gain

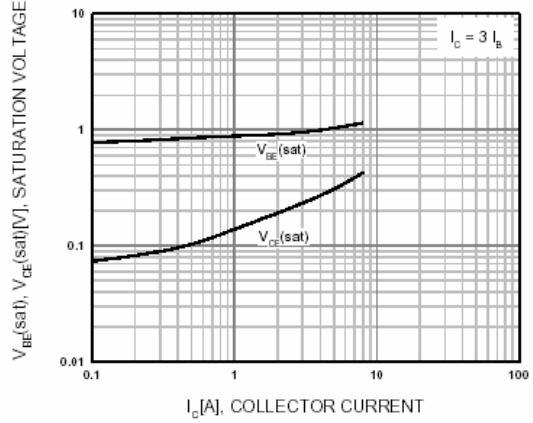


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

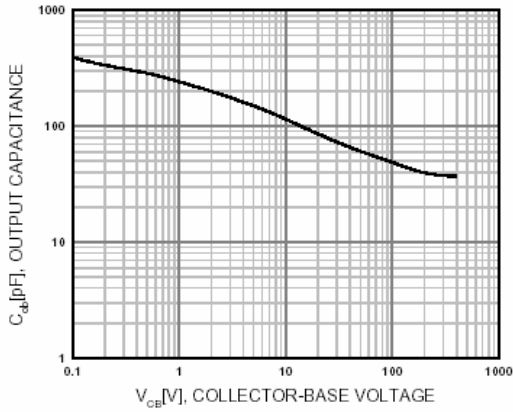


Figure 3. Collector Output Capacitance

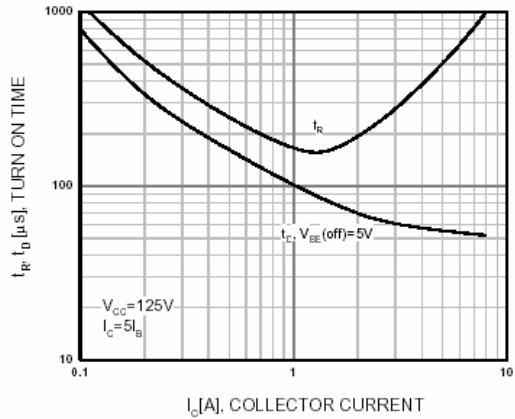


Figure 4. Turn On Time

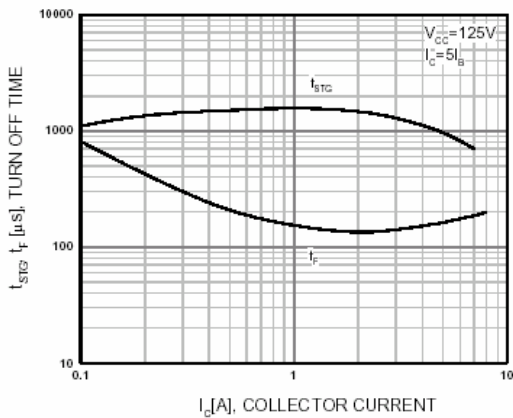


Figure 5. Turn Off Time

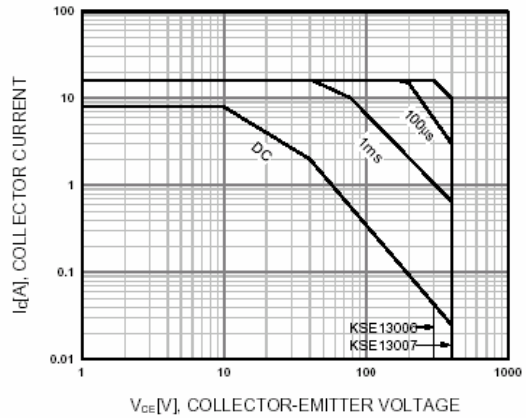


Figure 6. Safe Operating Area



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

KSH13007W

对应国外型号
KSE13007

■ 特性曲线

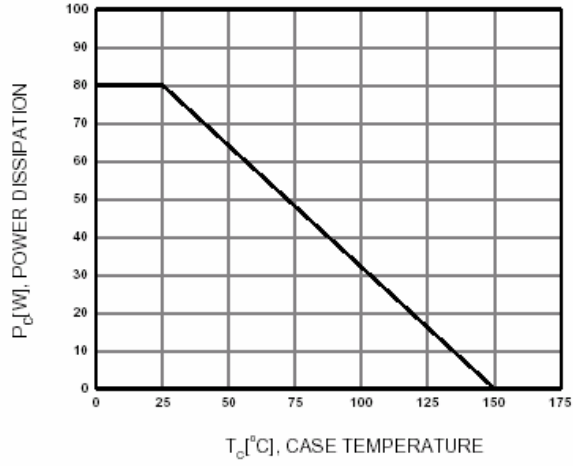


Figure 7. Power Derating